# 65nm バルクとThin BOX FD-SOI プロセスにおける 冗長化フリップフロップのソフトエラー耐性の実測と評価

曽根崎詠二<sup>†</sup> 久保田勘人<sup>†</sup> 増田 政基<sup>†</sup> 神田 翔平<sup>†</sup> 古田 潤<sup>†</sup>

小林 和淑<sup>†</sup>

↑ 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 電子システム工学専攻 〒 606-8585 京都市左京区松ヶ崎

あらまし 集積回路の微細化に伴って、ソフトエラーにより信頼性の低下が顕在化している。ソフトエラーの対策技術として TMRFF のような冗長化回路が多数提案されているが、冗長化回路は面積・消費電力が増大する。面積を削減するのは困難であるが、消費電力は低消費電力技術を用いることで削減できる。そこで、我々の研究グループでは高信頼性回路である BCDMR 構造と DICE 構造に低消費電力技術を組み合わせた BCDMRACFF と DICEACFF を提案した。本稿では、65nm バルクと Thin BOX FD-SOI プロセスでテストチップを試作し、BCDMRACFF と DICEACFF のソフトエラー耐性を評価した。バルクプロセスでは BCDMRACFF と DICEACFF のソフトエラー耐性を評価した。Thin BOX FD-SOI では両回路合わせてソフトエラーが一つしか発生せず、非常に高いソフトエラー耐性であることを示した。

キーワード ソフトエラー、BCDMR、冗長化、重イオン、低消費電力

## Evaluation of Soft Error Tolerance of Redundant Flip-Flop in 65nm Bulk and FD-SOI Processes

Eiji SONEZAKI<sup>†</sup>, Kanto KUBOTA<sup>†</sup>, Masaki MASUDA<sup>†</sup>, Shohei KANDA<sup>†</sup>, Jun FURUTA<sup>†</sup>, and

## Kazutoshi KOBAYASHI<sup>†</sup>

<sup>†</sup> Kyoto Institute of Teshnology Graduate School of Science and Technology

Abstract According to process down scaling, LSI becomes less reliable for soft errors. To increase the tolerance of FFs for soft errors, several redundant FF structures are proposed such as the TMR FF. However, the redundant FF has large area and power consumption overhead. Although it is very hard to reduce the area overhead, the power consumption overhead can be reduced to adapt low power consumption techniques. We proposed a low power consumption redundant FFs (BCDMRACFF, DICEACFF) by combining conventional redundant FFs (BCDMRFF, DICEFF) and low power consumption techniques. We evaluated tolerance for soft error of proposed FFs in 65nm Bulk and Thin BOX FD-SOI. In Bulk, tolerance of BCDMRACFF and DICEACFF have 20 and 17 times higher than TGFF, respectively. In Thin BOX FD-SOI, number of error in proposed FFs is only one. Thin BOX FD-SOI + BCDMR or DICE have very high tolerance for soft error.

 ${ { { Key words } } } { { soft error, BCDMR, redundant FF, heavy Ion, low power consumption } }$ 

## 1. 序 論

近年、集積回路に集積されるトランジスタの微細化に伴って、 信頼性の低下が顕在化してきた [1]。信頼性を低下させる要因の 一つにソフトエラーがある。ソフトエラーとは、 <sup>(4)</sup> 粒子や中性 子、重イオンがデバイス内に突入してきたことで発生する一時 的な故障のことである [2]。再起動や命令の再実行により修復可 能であるが、航空機や自動車、医療機器など高い信頼性が求め られる製品では一度の故障でも重大な事故を引き起こしかねな いため、ソフトエラー対策は必須である[3]。ソフトエラーの対 策には MOSFET のソース・ドレインの直下に絶縁層を埋め込 むことでボディと基板を分離したデバイスである SOI (Sillicon On insulator) プロセスなどがデバイスレベルの対策として用い られている。バルクプロセスに比べてデバイスの製造工程が増 えるためコストが高いため、FF を多重化するなど回路レベルの 対策が主流であり、現在までに TMR (Triple Modular Redundancy) [4], DICE (Dual Interlocked strage CEII) [5]、BISER (Built In Soft Error Resilience) [6] など多様な耐ソフトエラー FF が提案されている。耐ソフトエラー FF は冗長化により高 い信頼性を有するが、面積および消費電力のオーバーヘッドと トレードオフの関係にある。トランジスタを追加するために面 積オーバーヘッドを減らすのは非常に難しいが、電力オーバー ヘッドは低消費電力技術により削減可能である。我々の研究グ ループでは低消費電力回路である ACFF に DICE 構造または BISER を改良した BCDMR 構造を組み合わせることで高性能 かつ高信頼性冗長化 FF を提案する。

本稿の構成は以下の通りである。2節で提案回路を含む冗長 化FFの回路構造について述べる。3節では設計したテストチッ プの概要について述べる。4節では重イオン照射試験の実験方 法と実験結果について述べる。5節では結論を述べる。

#### 2. 低消費電力冗長化 FF

本章では非冗長化 FF や冗長化 FF について述べた後に提案 する低消費電力冗長化 FF について述べる。

#### 2.1 TGFF

現在一般的に用いられている D 型 FF である TGFF (Transimission Gate Flip-Flop)の回路図を図1に示す。非冗長化 FF であり、耐ソフトエラー回路や低消費電力回路ではない。 様々な FF の評価を行う際、TGFF を基準として用いる。マ スターラッチとスレーブラッチの2つのラッチの組み合わせに よって構成されており、2つのラッチの間はトランスミッショ ンゲートで接続している。CLK=1 だとマスターラッチが保持 し、CLK=0 だとスレーブラッチが値を保持する。CLK 信号の 立ち上がりもしくは立ち下がりで値を切り替える。



### 2.2 ACFF

ACFF (Adaptive Coupling Flip-Flop)の回路図を図2に示 す[7]。ACFFもTGFFと同様に非冗長化FFであり、耐ソフ トエラー回路ではないが、AC素子を用いた低消費電力回路で ある。ACFFはTGFFと異なり、ラッチの切り替えにパスト ランジスタを用いているためクロックの逆相の信号が不必要と なるため、クロックバッファを排除できる。低活性化率領域で はクロックバッファでの消費電力が支配的になるため、クロッ クバッファのないACFFは低消費電力を実現できる。



#### 2.3 BCDMR FF

BCDMRFF (Bistable Cross-coupled Dual Modular Redundancy Flip-Flop)の回路図を図3に示す[8]。TGFFを 二重化し、マスターラッチとスレーブラッチの後段に"2C+ K"を挿入した冗長化FFである。"2C+K"は2つのMuller's C-element と一つのKeeper でできている。もし、2つのラッ チのうちー方でソフトエラーが発生してもC-element が八イイ ンピーダンスになり、Keeper が元の信号を保持する。BCDM-RFFでソフトエラーが起こるには2つのラッチとKeeperの うち2つが反転する必要があるために高い信頼性を有する。 BCDMRFFはC-elementを二重化することによりBISERの 欠点を改良した回路である。C-elementを二重化することで、 C-element で発生したノイズパルスであるSET (Single Event Transient)によるエラーも防ぐことができる[8]。



⊠ 3 BCDMRFF

#### 2.4 BCDMR ACFF

BCDMR ACFF の回路図を図4に示す。ACFF に BCDMR 構造を適用した冗長化 FF である。BCDMRFF と同様に Keeper と2つの C-element がそれぞれのラッチに挿入されている。Celement で発生する SET によるエラーにも強い。C-element と Keeper を挿入する都合により、スレーブラッチにはインバー タが挿入されている。ACFF を基にした冗長化回路であるため 低活性化率領域では低消費電力を実現できる。

#### 2.5 DICE ACFF

DICE (Dual Interlocked CEll) ACFF の回路図を図 5 に示



す。ACFF に DICE 構造を適用した冗長化 FF である。DICE 構造とはラッチが二重化された構造である。通常のラッチの ループ構造はインバータ二段で構成されるが、DICE のループ 構造は Half-C-element (HCE) と呼ばれるインバータ4 段で構 成される。4 段のループ構造によって1 つの HCE の出力が反 転しても他の3 つの HCE によって値が補償される。ACFF を 基にした冗長化回路であるため低活性化率領域では低消費電力 を実現できる。



3. テストチップ

本節では提案した低消費電力冗長化 FF と非冗長化 FF の ソフトエラー耐性を評価するために設計した 65nm バルクと Thin BOX FD-SOI プロセスのチップ概要と各 FF の性能比較 結果について述べる。

## 3.1 SOTB

完全空乏型 SOI (Fully Depleted Sillicon on Insulator) プロ セスの一種である SOTB (Sillicon On Thin BOX) を図 6 に 示す。通常の SOI の絶縁膜厚はおおよそ 100nm であるのに対 し、SOTB はシリコン基板上に 10nm 程度の極薄の BOX 層と 12nm のシリコン薄膜 (SOI 層) が形成されたトランジスタであ る。SOTB はバルクプロセスに比べて高いソフトエラー耐性を 有するトランジスタである [10]。その理由はソフトエラーが発 生する要因である誘起電荷収集を抑制できるからである。誘起 電荷収集とは、粒子線により基板で発生したキャリアがドレイ ン領域に収集されることである。この現象により論理ゲートの 出力にノイズが発生する。SOTB では BOX 層により基板で発 生したキャリアが収集されずに発生するノイズが小さくなる、 もしくは発生しなくなるため高いソフトエラー耐性を実現でき る[11]。



図 6 (a) SOTB / (b) バルクのトランジスタ構造

#### 3.2 Double Height Cell 構造

冗長化 FF を設計する際に使用した DHC (Double Height Cell)構造を図7に示す。通常使用されるのは SHC (Single Height Cell)構造であるが、冗長化 FF のように多くのトラン ジスタを SHC で配置するとラッチ間の配線を行うことが困難 になるためにセル内に占めるトランジスタ配置領域を効率良く 拡張できる方法としてよく用いられる DHC 構造を適用した。 DHC 構造にすることで配線の簡略化するだけでなく、pWell を分離した構造を取ることで、MCU の発生率を下げることが できる。正孔の移動度より電子の移動度の方が高いため拡散距 離が長く、拡散領域に取り込まれやすいからである。



図 7 ダブルハイトセル構造

## 3.3 単一粒子による多ビットエラーを考慮したレイアウト 構造

冗長化 FF において最も考慮すべき問題が MCU (Multiple Cell Upset) である。MCU とは単一の粒子により複数のセル が反転するエラーのことである。MCU の発生原理として、寄 生バイポーラ効果と電荷共有、連続衝突が挙げられるが、これ らの現象は同時に反転するとソフトエラーを引き起こすラッチ やノードの距離を空けることで解消できる。本研究でも全ての 冗長化 FF に対して MCU を考慮したレイアウト構造を用いて いる。例として BCDMRFF のレイアウト構造を図 8 に示す。 BCDMRFF は 2 つのラッチと Keeper で値を保持しているた め、面積が変わらない範囲でできるだけ離れるような構造に した。

Slave	Master	CLK	2C-element	
Latch0	Latch0		+Keeper (SL)	
Master	Slave	CLK	2C-element	
Latch1	Latch1		+Keeper (ML)	

図 8 レイアウト構造を工夫した BCDMRFF。 "0" が上部のラッチ。 "1" が下部のラッチ。

## 3.4 テストチップの概要

本研究に用いたテストチップとレイアウトパターンを図9に 示す。テストチップは65nm SOTBとバルクプロセスで設計 を行った。バルクとSOTBによるFFのソフトエラー耐性を 実測・評価できるように、同様のレイアウトで同じ回路を有す るテストチップをそれぞれ作成した。利用したプロセスでは、 BOX 層を追加する層を排除することでバルクチップの製造を 委託した。

テストチップには TGFF, ACFF, TMRFF, BCDMRFF, BCDMRACFF, DICEFF, DICEACFF の7種類の FF アレ イを搭載した。各 FF の搭載ビット数は図9に示す。TMRFF と BCDMR 構造は面積の都合上他の回路より少ない17,280bit と 34,560bit であり、それ以外は全て 40,320bit 搭載している。



図 9 テストチップの構造

#### 3.5 非冗長化 FF および冗長化 FF の性能比較

65nm プロセスで設計した各 FF のトランジスタ数、面積、 遅延時間、消費電力について TGFF を基準として比較した結 果を表 1 に示す。活性化率  $\alpha = 0\% - 100\%$ までの消費電力の 比較は図 10 に示す。電源電圧は 1.2V として Spice シミュレー ションを行った。

冗長化 FF はトランジスタ数を追加する必要があるため、 面積オーバーヘッドが非常に大きい。特に本研究で設計した TMRFF は Voter も三重化したために TGFF の 5.2 倍もの面積 を有する。それに比べて BCMDR 構造では 2.4-2.5 倍、DICE 構造では 2.0-2.1 倍と小面積で設計することができる。

消費電力に関してはローカルクロックバッファを排除した ACFF、BCDMRACFF、DICEACFF は低活性化率領域にお いて TGFF を下回った。活性化率は一般的に 5-15% なので、  $\alpha$ =10%で比較すると、BCDMRACFF の消費電力は従来の BCDMRFF の 40%程度に抑えることができる。DICEACFF の消費電力は従来の DICEFF の 40%程度に抑えることがで きる。

この結果より ACFF を基にした冗長化 FF は従来の冗長化 FF とほぼ同じ面積で、遅延時間、消費電力において高性能で あることを示した。

表 1	苔 FF	の面積	・遅延時間	・消費電刀	(TGFF	で規格化

				消費電力	
$\mathbf{FF}$	トランジスタ数	面積	遅延	$\alpha = 10\%$	$\alpha {=} 100\%$
TGFF	28	1.00	1.00	1.00	1.00
ACFF	24	0.85	0.49	0.38	0.91
TMRFF	126	5.20	1.52	3.21	4.08
BCDMRFF	72	2.50	1.75	2.40	3.17
BCDMRACFF	72	2.40	1.15	0.97	2.95
DICEFF	56	2.00	1.29	1.92	2.09
DICEACFF	48	2.10	0.86	0.77	2.07



図 10 各 FF の活性化率 vs 消費電力 (TGFF で規格化)

## 4. 重イオン照射試験の実験方法と実測結果

本節では提案した冗長化 FF のソフトエラー耐性を評価する ために行った重イオン照射試験の実験方法と実験結果について 述べる。

4.1 実験方法

本研究では、JAEA 高崎量子研究所 (TIARA:Takasaki Ion accelerators for Advanced Radiation Application) で重イオ ン照射試験を行った。重イオンのエネルギーは空気により大き く減衰するので、実験は真空で行う必要がある。そのためチャ ンバー内にテストチップを固定し、真空状態にして重イオン照 射を行った。TIARA では表 2 に示すように 5 種類のイオンが 使用可能であるが、使用するイオンを交換するときに時間が



図 11 バルクプロセスにおける BCDMR 構造と非冗長化 FF の Cross-Section

かかるため、本研究では 2 種類 (Kr, Ar) のイオンのみを使用 した。

測定条件について示す。テストチップに対して直角方向からのみ重イオンを照射し、電源電圧を標準電圧である 1.2V とした。入力するデータ及びクロックは (Data, CLK) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) の条件について測定した。測定回数は各条件につき 1 回ずつである。

重イオン照射試験においてソフトエラー率の比較を行う場合 は衝突断面積 (CS (Cross Section)) と呼ばれる単位を用いる。 衝突断面積とは粒子が通過するとソフトエラーを引き起こす面 積のことであり、式 (1) で表される。Cross Section に単位面 積当たりの照射粒子数とビット数をかけることでエラー数とな る。Nerror が重イオン照射により発生したエラー数、Nion が単 位面積にあたりに照射されるイオン総数、NFF が FF のビット 数である。

$$CS[cm2/bit] = \frac{N_{error}}{N_{ion} \times N_{FF}}$$
(1)

#### 表 2 TIARA にて照射可能な重イオン粒子.本研究で用いた粒子は Ar, Kr のみである.

重イオン	Energy[MeV]	$LET[MeV/(cm^2/mg)]$	Range[um]
N	56	3.4	49.2
Ne	75	6.6	39.0
Ar	150	15.8	36.1
Kr	322	40.3	37.3
Xe	454	64.0	34.6

#### 4.2 実測結果

バルクプロセスにおいて BCDMR 構造および DICE 構造と 非冗長化 FF を比較した結果をそれぞれ図 11 と図 12 に示す。 各 FF の Cross Section は測定した 4 つの条件の平均値であ る。BCDMR 構造や DICE 構造を適用した冗長化 FF は非冗 長化 FF よりも Cross Section が減少し、ソフトエラー耐性が 向上した。LET = 40 MeV/(cm<sup>2</sup>/mg) の Kr を照射した場合 では BCDMR 構造のソフトエラー耐性は TGFF の 10-20 倍程 度向上し、DICE 構造のソフトエラー耐性は TGFF の 7-17 倍 程度向上した。どちらの構造も ACFF に冗長化を施した回路



図 12 バルクプロセスにおける DICE 構造と非冗長化 FF の Cross-Section





図 13 SOTB における BCDMR 構造と非冗長化 FF の Cross-Section

図 14 SOTB における BCDMR 構造と非冗長化 FFの Cross-Section

(BCDMRACFF, DICEACFF) のほうが高いソフトエラー耐 性を示したが、バルクプロセスかつ高 LET の重イオン照射では レイアウト構造を工夫しても MCU の影響が大きく、BCDMR 構造や DICE 構造でも多くのソフトエラーが観測された。

SOTB において BCDMR 構造および DICE 構造と非冗長化 FF を比較した結果をそれぞれ図 13 と図 14 に示す。各 FF の Cross Section は測定した 4 つの条件の平均値である。Kr を照 射した時の TGFF の Cross-Section は  $1.11 \times 10^{-9} \text{ cm}^2$ /bit であったため、バルクプロセスの BCDMR 構造および DICE 構造よりも高いソフトエラー耐性を示した。SOTB は SOI 層 と基板が BOX 層で分離されているために基板電位変動や電荷 共有の影響を受けないからである。同様の理由で、高信頼性の BCDMR 構造や DICE 構造と SOTB を組み合わせることで 高 LET の重イオンである Kr でもソフトエラーがほとんど起こ らない冗長化 FF を実現することができた。

#### 5. 結 論

本稿では高信頼性回路である BCDMR 構造および DICE 構 造に低消費電力フリップフロップである ACFF を組み合わせ た BCDMRACFF と DICEACFF を含む計 6 種類の非冗長化 FF および冗長化 FF の設計・評価を行った。

BCDMRACFF および DICEACFF は従来の BCDMR 構造 や DICE 構造と同程度の面積を保ちつつ、低活性化率  $\alpha$ =10%で は従来の BCDMRFF や DICEFF の 40%程度に抑えるなど遅 延時間・消費電力において高い性能を実現した。

65nm バルクと SOTB プロセスにてテストチップを試作し、重 イオン照射試験を行った。バルクプロセスでは BCDMRACFF のソフトエラー耐性は非冗長化 FF である TGFF の約 20 倍か つ従来の BCDMRFF の約 2 倍であった。また、DICEACFF のソフトエラー耐性は TGFF の約 17 倍かつ従来の DICEFF の約 2.5 倍であった。しかし、レイアウト構造を工夫しても高 LET 環境では、MCU の影響が大きく、冗長化を施しても多く のエラーが観測された。SOTB では BCDMR 構造も DICE 構 造もソフトエラーが一つしか発生せず、高 LET である Kr で も非常に高いソフトエラー耐性を示した。これにより宇宙空間 などの高 LET 環境において高信頼性を実現するには SOTB と BCDMR 構造または DICE 構造を組み合わせるべきである。

今後は、宇宙空間での仕様なども視野に入れて直角照射のみ ならず重イオンの角度依存性等々を測定していく予定である。

#### 謝 辞

本研究は JSPS 科研費 15H02677, 26889037, STARC 共同 研究の助成を受けて実施したものである。また、東京大学大規 模集積システム設計教育研究センターを通し、シノプシス株式 会社,日本ケイデンス株式会社,メンター株式会社の協力で行 われたものである。

#### 文 献

- N. Seifert, P. Slankard, M. Kirsch, B. Narasimham, V. Zia, C. Brookreson, A. Vo, S. Mitra, B. Gill, and J. Maiz, "Radiation-Induced Soft Error Rates of Advanced CMOS Bulk Devices", *Proc. Int. Rel. Phys. Symp.*, (2006), pp. 217–225.
- [2] "戸坂義春", ""知っておきたいソフト・エラーの実態"", "日経 エレクトロニクス", 2005 年 7 月 24 日号, (2005).
- [3] J. Wilkinson and S. Hareland, "A cautionary tale of soft errors induced by SRAM pack-aging materials", *IEEE Transaction on Device and Materials Reliability*, Vol. 5, (2005), pp. 428–433.
- [4] DG Mavis and PH Eaton, "Soft error rate mitigation techniques for modern microcircuits", Proc. Int. Rel. Phys. Symp., (2002), pp. 216–225.
- [5] D. Krueger, E. Francom, and J. Langsdorf, "Circuit design for voltage scaling and SER immunity on a quad-core Itanium processor", *ISSCC*, (2008), pp. 94–95.
- [6] M. Zhang, S. Mitra, T. M. Mak, N. Seifert, N. J. Wang, Q. Shi, K. S. Kim, N. R. Shanbhag, and S. J. Patel, "Sequential Element Design with Built-In Soft Error Resilience", *IEEE Trans. VLSI Sys.*, Vol. 14, No. 12, pp. 1368–1378, (2006).
- [7] K. T. Chen, T. Fujita, H. Hara, and M. Hamada, "A 77%

energy-saving 22-transistor single-phase-clocking D-flip-flop with adaptive-coupling configuration in 40nm CMOS", *ISSCC*, (2011), pp. 338–340.

- [8] J. Furuta, C. Hamanaka, K. Kobayashi, and H. Onodera, "A 65nm Bistable Cross-coupled Dual Modular Redundancy Flip-FlopCapable of Protecting Soft Errors on the C-element", *ISSCC*, (2010), pp. 123–124.
- [9] C. Hamanaka, R. Yamamoto, J. Furuta, K. Kobayashi, and H. Onodera, "Variation-Tolerance of a 65-nm Error-Hardened Dual-Modular-Redundancy Flip-Flop Measured by Shift-Register-Based Monitor Structures", *IEICE Trans.*, (2011), pp. 2669–2675.
- [10] J. Furuta, E. Sonezaki, and K. Kobayashi, "Radiation hardness evaluations of 65nm fully depleted silicon on insulator and bulk processes by measuring single event transient pulse widths and single event upset rates", JJAP, (2015), pp. 04DC15–1–6.
- [11] D. Kobayashi, K. Hirose, H. Ikeda, and H. Saito, "Radiation-induced pulse noise in SOI CMOS logic", Int'l Symposium on Advanced Semiconductor-on-insulator Technology and Related Physics (in 219th ECS Meeting), (2011).